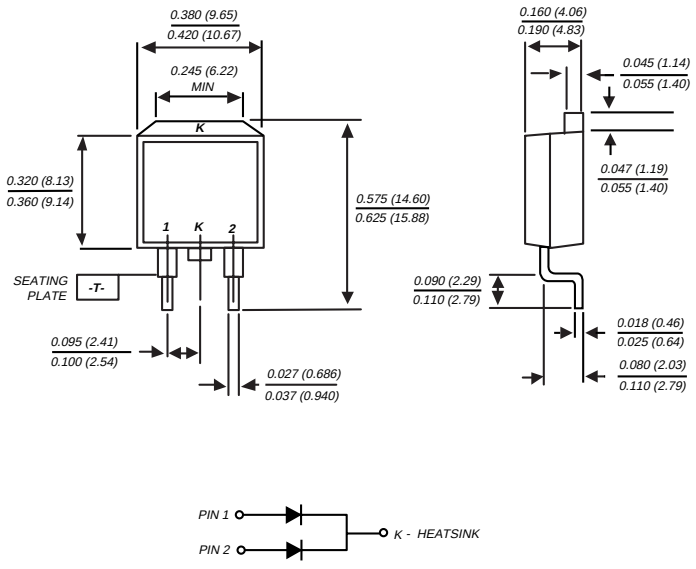
FEPB6AT THRU FEPB6DT

FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER

***Reverse Voltage** - 50 to 200 Volts* ***Forward Current** - 6.0 Amperes*

TO-263AB



Dimensions are in inches and (millimeters)

FEATURES



- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- Dual rectifier construction, positive center-tap
- Glass passivated chip junctions
- Superfast recovery times for high efficiency
- Low power loss
- Low forward voltage, high current capability
- For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications
- High temperature soldering in accordance with CECC 802 / Reflow guaranteed

MECHANICAL DATA

Case: JEDEC TO-263AB molded plastic body
Terminals: Plated lead solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: As marked
Mounting Position: Any
Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	SYMBOLS	*FEPB6AT*	*FEPB6BT*	*FEPB6CT*	*FEPB6DT*	*UNITS*
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	Volts
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	Volts
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	Volts
Maximum average forward rectified current T_C=100°C	$I_{(AV)}$	6.0				Amps
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	100.0				Amps
Maximum instantaneous forward voltage per leg at 3.0A	V_F	0.975				Volts
Maximum DC reverse current T_C=25°C at rated DC blocking voltage T_C=100°C	I_R	5.0 50.0				µA
Maximum reverse recovery time per leg (NOTE 1)	t_{rr}	35.0				ns
Typical thermal resistance (NOTE 2)	$R_{\Theta JC}$	3.6				°C/W
Typical junction capacitance per leg (NOTE 3)	C_J	28.0				pF
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	-55 to +150				°C

NOTES:
(1) Reverse recovery test conditions: I_F=0.5A, I_r=1.0A, I_{rr}=0.25A
(2) Thermal resistance from junction to case per leg mounted on heatsink
(3) Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts

GENERAL SEMICONDUCTOR®

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES FEPB6AT THRU FEPB6DT

FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE

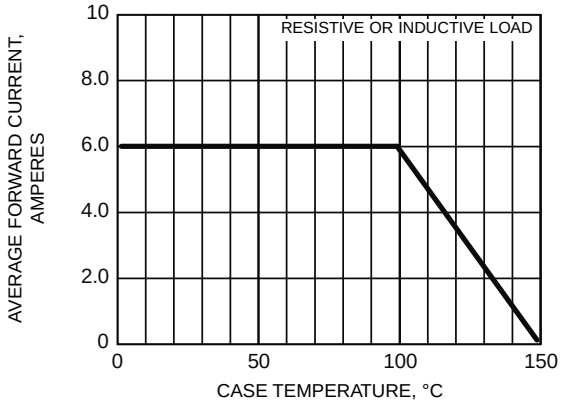


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

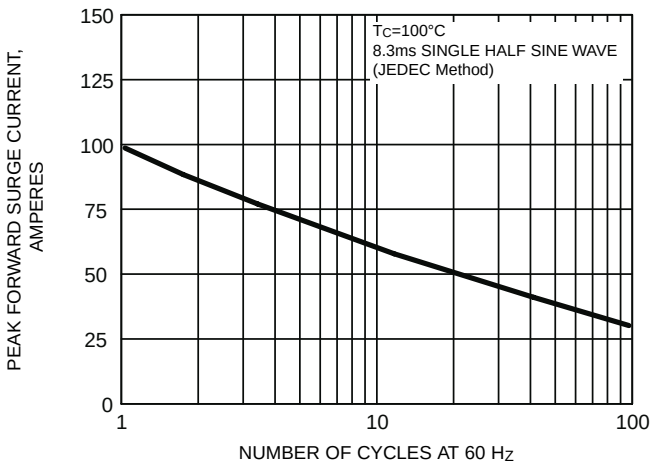


FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

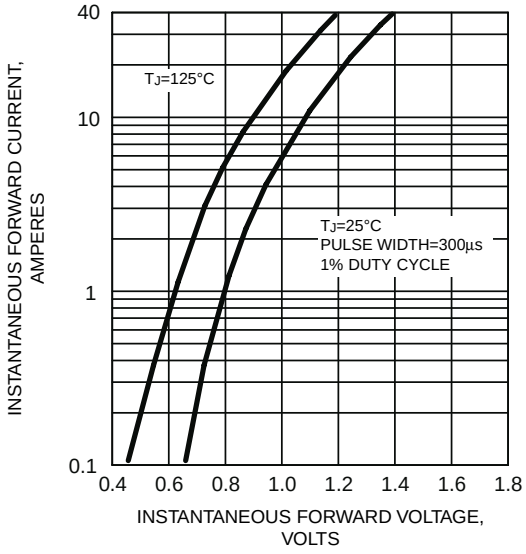


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

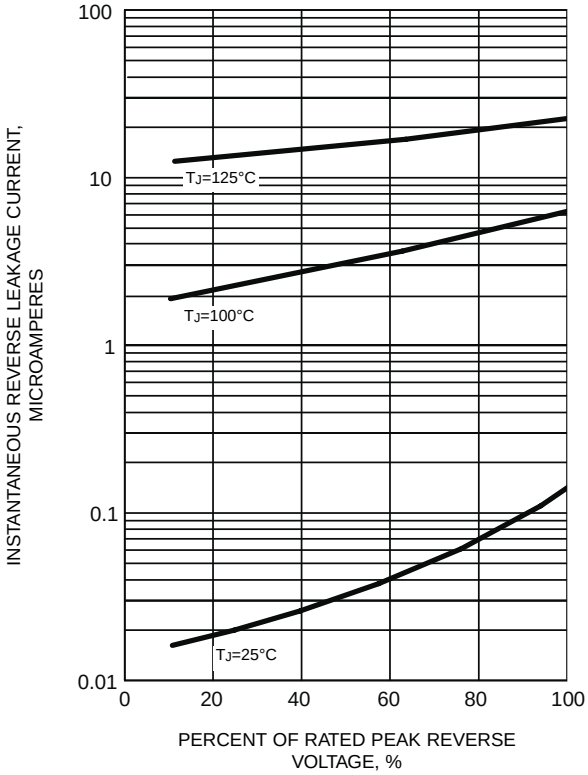
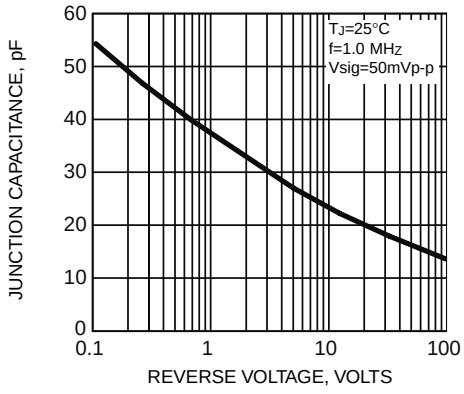


FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG



GENERAL SEMICONDUCTOR®

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9